

□ 2T877A, 2T877B, 2T877В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$ составные универсальные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами и стеклянными изоляторами. Масса транзистора не более 20 г.



2T877 (A-B)

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ}=10$ В, $I_E=10$ А:

2T877A 750...10000

2T877B, 2T877B 2500...18000

Границчная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КЭ}=5$ В,

$I_K = 3$ А,

не менее 100 МГц

Границное напряжение при $I_K = 0,1$ А, не менее:

2T877A 80 В

2T877B 60 В

2T877B 40 В

Напряжение насыщения коллектор - эмиттер при $I_K = 10$ А, $I_B = 0,04$ А, не более	2 В
Напряжение насыщения база - эмиттер при $I_K = 10$ А, $I_B = 0,04$ А, не более	3 В
Время включения при $U_{КЭ} = 20$ В, $I_K = 10$ А, $I_B = 0,04$ А, типовое значение	0,22* мкс
Время выключения при $U_{КЭ} = 20$ В, $I_K = 10$ А, $I_B = 0,04$ А, типовое значение	0,75* мкс
Время спада при $U_{КЭ} = 20$ В, $I_K = 10$ А, $I_B = 0,04$ А, типовое значение	0,3* мкс
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 20$ В, типовое значение	830* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 3$ В, типовое значение	1300* пФ
Обратный ток коллектор - эмиттер при $U_{КЭ} = U_{КЭ, макс}, U_{ЭБ} = 1,5$ В, не более	1 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 5$ В, не более	5 мА

Пределные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор - база:

2T877A 80 В

2T877B 60 В

2T877B 40 В

Постоянное напряжение коллектор - эмиттер:

2T877A 80 В

2T877B 60 В

2T877B 40 В

Постоянное напряжение эмиттер - база

Постоянный ток коллектора 5 В

Импульсный ток коллектора при $t_i = 10$ мс 20 А

Постоянный ток базы 40 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при $T_K = -60 \dots +25^\circ\text{C}$:

с теплоотводом 50 Вт

без теплоотвода 3 Вт

Temperatura $p-n$ перехода +175°C

Temperatura окружающей среды -60°C, $T_K = +125^\circ\text{C}$

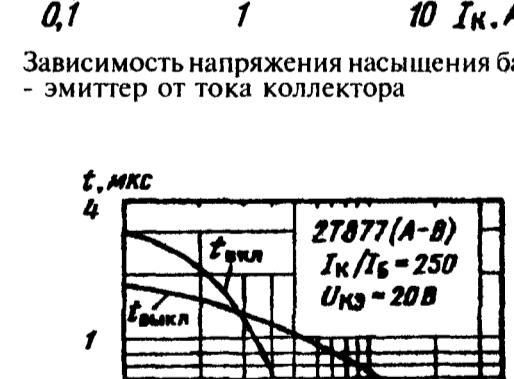
¹ При $T_K > +25^\circ\text{C}$ $P_{K, \text{макс}}$ снижается линейно на 0,44 Вт/°C с теплоотводом и на 20 мВт/°C без теплоотвода.

$U_{КЭ, \text{макс}}, \text{В}$

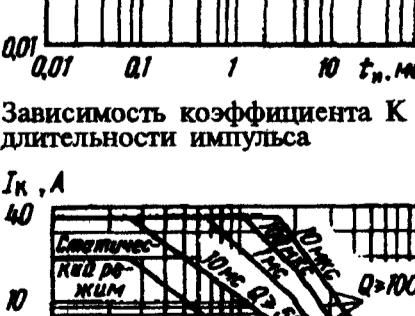


Зависимость напряжения насыщения коллектор - эмиттер от тока коллектора

$U_{БЭ, \text{макс}}, \text{В}$

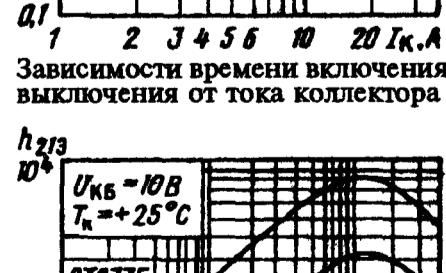


Зависимость напряжения насыщения база - эмиттер от тока коллектора



Зависимость коэффициента К от длительности импульса

$t, \text{мкс}$



Зависимости времени включения и выключения от тока коллектора



Области безопасной работы транзисторов



Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера